12-7 微細照射を可能にする高品位なイオンビーム生成のために -サイクロトロンビームの高安定化技術の開発-



図12-15 TIARAサイクロトロン 上部の鉄心部分を除いてサイクロトロン内部を見易くしてあります。 イオンビームを電磁石中で回転させながらディー電圧で加速して徐々 に回転半径を増加させ、デフレクタなどのビーム引き出し機器で外へ



イオン照射研究施設TIARA (Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)のサイクロトロン (図12-15)が生成するイオンビームは、植物育種やRI製 造、宇宙用半導体の耐放射線性試験など、バイオ・材料 科学研究を中心に機構内外のユーザーに広く利用されて います。なかでも現在注目されているのが、通常数mm あるイオンビームのサイズをミクロンオーダーに細く 絞った「マイクロビーム」で、微細部位へのイオンビー ムの狙い撃ちを可能にし、細胞の応答機構の解明などバ イオ・ナノテクノロジーへの応用が期待されています。 しかし、サイクロトロンで生成するイオンビームには安 定度の問題があり、ビームの位相、軌道、強度などに変 動が生じていました。そのため、「マイクロビーム」に必 要なエネルギーの揃ったビームなど、高品位なビーム生 成を可能にする精密な調整は困難であると考えられてき ました。

そこで、TIARAサイクロトロンでは、ビームの高安定 化に取り組みました。高周波ノイズで困難であったサイ クロトロン電磁石の高精度な磁場計測をプローブの開発



図12-16 電磁石温度のシミュレーション 実測温度測定データに基づいて計算したサイクロトロン 電磁石内部の温度分布です。安定化技術による対策後は ほぼ初期温度25度を維持しています。

図12-17 磁場とビーム強度の変化 左のグラフはサイクロトロン内部の磁場の変化を、右 のグラフはビーム強度の変化を示しています。従来は 変動が大きく、電磁石の再調整を行わないとグラフの ようにビーム強度が減少していました。安定化技術に よって電磁石の再調整をすることなくビーム強度はほ ぽ一定となっています。

によって実現し、ビーム変動が磁場の変化で引き起こさ れること、そして、サイクロトロン電磁石のコイルの発 熱による電磁石鉄心温度上昇でその磁場の変化が生じて いること、を明らかにしました。このコイルからの熱流 入を防止し、鉄心温度上昇を抑制する機構を有した(図 12-16)電磁石温度制御システムの開発に成功しました。 以前の磁場は0.01%以上変動していましたが、このシス テムの開発によって、現在は0.001%以内という世界で 最も安定した磁場が実現でき、再調整することなく生成 ビーム強度はほぼ一定となりました(図12-17)。

ビーム径1µmの「マイクロビーム」形成では、エネ ルギー幅0.02%のビームが必要です。この高安定磁場に よってビーム位相が従来より一桁精度良く制御可能と なったことでエネルギー利得の均一化が図れ、目的のエ ネルギー幅達成が可能となりました。本高安定化技術 は、「マイクロビーム」のみならず、医療を含めた様々 なサイクロトロンのイオンビーム応用の基盤技術となっ ています。

●参考文献

Okumura, S. et al., Magnetic Field Stabilization by Temperature Control of an Azimuthally Varying Field Cyclotron Magnet, Review of Scientific Instruments, vol.76, no.3, 2005, p.033301-1-033301-6.